

③公開実用新案公報(U) 昭60-116239

④Int.Cl.

H 01 L 21/60
23/34
29/78

識別記号

厅内整理番号

6732-5F
6616-5F
8422-5F

⑤公開 昭和60年(1985)8月6日

審査請求 未請求 (全2頁)

⑥考案の名称 パワー-MOSFETの実装構造

⑦実 頼 昭59-2858

⑧出 頼 昭59(1984)1月12日

⑨考案者 富永保 横須賀市夏島町1番地 日産自動車株式会社追浜工場内

⑩考案者 高辻吉明 東京都大田区大森西5丁目28番6号 ナイルス部品株式会社内

⑪出願人 日産自動車株式会社 横浜市神奈川区宝町2番地

⑫出願人 ナイルス部品株式会社 東京都大田区大森西5丁目28番6号

⑬代理人 弁理士 和田成則

⑭実用新案登録請求の範囲

半導体基体の1主面をドレインとし、他の主面にゲートとソースを形成する縦型パワーMOSFETにおいて：

前記ゲート、ソースが形成されている領域面上に、絶縁層を介してソース配線層を形成するとともに、該ソース配線層上には金属片を接着し、該金属片とリードフレームとの間をワイヤボンディングで接続することを特徴とするパワーMOSFETの実装構造。

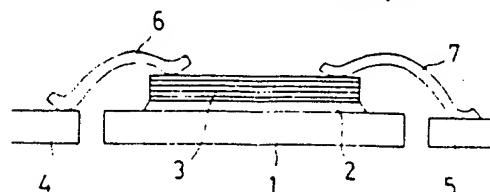
図面の簡単な説明

第1図は従来の実装構造を示す断面図、第2図

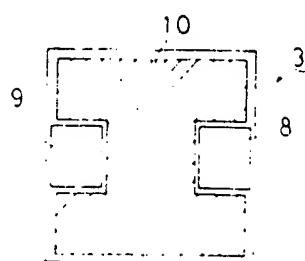
は同平面図、第3図は同素子断面図、第4図は本考案に係わるパワーMOSチップの素子断面図、第5図は同平面図、第6図は本考案に係わる実装構造の断面図である。

13…ドレイン層、14…ゲートSiO₂膜、16…パワーMOSチップ、17…ソース領域、18…ゲート層、19…絶縁層、20…ソース配線層、21…ゲートパッド、22…素子形成領域、23…ドレイン側の放熱板、25…軟ろう材または導電性接着剤、26…金属片、27…ソース電極となるリードフレーム、28…細線、29…ゲース電極となるリードフレーム、30…細線。

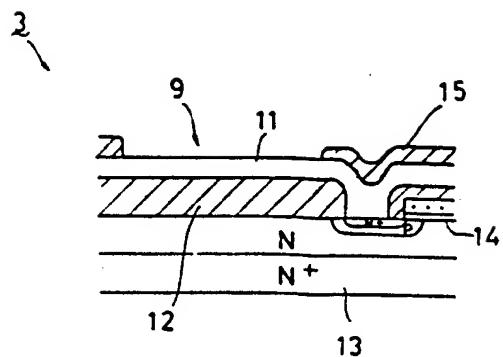
第1図



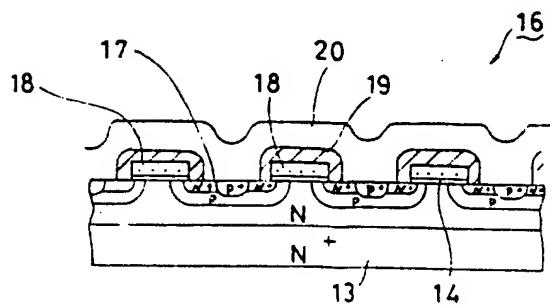
第2図



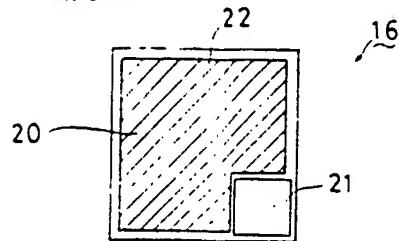
第3図



第4図



第5図



第6図

